## ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭62-54228

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和62年(198	7)3月9日
G 02 F	1/133 1/13 9/35	125	8205-2H 7448-2H		٠		
G 09 F	9/35	101	6810-5C	審査請求	未請求	発明の数 1	(全6頁)

**②発明の名称** 液晶表示装置の作製方法

②特 頤 昭60-155836

❷出 願 昭60(1985) 7月15日

0発	明	者	Щ	崎	舜	平	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
@発	明	者	小	沼	利	光	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
0発	明	者	浜	谷	敏	次	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
0発	明	者	問	類		晃	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ

1 願 人 株式会社 半導体エネ 厚木市長谷398番地

ルギー研究所

最終頁に続く

明 知 書

1.発明の名称

被晶皮示装置の作製方法

- 2.特許額求の範囲
  - 1.電極を互いに有する一対の基板を有する面を 内側にして対向せしめ、前記電極間にスメク チック液晶を充塡した液晶セルにおいて、前 記基板の電極間にスメクチック液晶を充塡し た後、前記一対の基板の周辺部を封止せしめ ることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
- . 2. 特許請求の範囲第1項において、スメクチック液晶は強誘電性液晶よりなることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
- 3.特許請求の範囲第1項において、覚極間は4 µ以下を有することを特徴とする液晶表示装 置の作製方法。
- -3. 発明の詳細な説明
- 「発明の利用分野」

この発明は、液晶表示装置の作製方法に関する ものであって、スメクチック液晶(以下Sa液晶ま たは液晶という)特に例えば強誘電性液晶(以下 FLC という)を用いた表示パネルを設けることに より、マイクロコンピュータ、ワードプロセッサ またはテレビ等の表示部の消膜化を図る液晶表示 装置の作製方法に関するものである。

#### 「従来の技術」

固体表示パネルは各終素を独立に制御する方式が大面積用として有効である。このようなパネルとして、従来は、二周波液晶例えばツウィスティック・ネマチック敵晶(以下TN液晶という)を用い、機方向400素子また縦方向200素子とするA4料サイズの単純マトリックス構成にマルチプレキシング駆動方式を用いた表示装置が知られている。

しかし、かかるTH液晶を作製せんとした場合、このTN液晶の粘度が低いため、一対のガラス基板を5~10μの間隙をあけて対抗せしめ、この一対のガラス基板の周辺部に封止用シール剤をスペーサを混合して塗布し、お互いを密着させる。この時周辺のシール部の一部の封止をせず、開介を残存して設けておく。この後この周辺が封止された

(1)

(2)

一対の基板を真空容器内に保持し、全体を真空引きする。さらに、この後この間穴部分をTN液晶溶液中に浸し、この真空容器内を大気圧にすることにより、毛細管現象を利用して一対の基版間の5~10μの間の空隙に液晶を充壌せんとするものであった。

「発明が解決しようとする問題点」

しかしかかる方法は、TN液晶の如き窒温で低粘 度の液晶を基板間に充壌する場合には優れている。 しかし、

- (1) 粘度の高いスメクチック液晶例えばSmC\*層を 用いるPLC に対してはきわめて作業がしづら い。
- (2) セルの電極間の間隊を4µ以下好ましくは0.5 ~ 3µの狭い間隊を用いることを前提とする FLC を用いる場合、充塡にきわめて時間がか かってしまう。
- (3) PLC を大面積例えばA 4版に対し充塡せんと する場合、8~10時間もの長時間高温例えば 120 でで充塡作業を必要とする。そのため、

(3)

(SnC\*) を呈する強誘電性液晶を用いる。即ちセルの間隔を 4 μmまたはそれ以下の一般には0.5 ~ 3 μmとすることにより双安定状態を得ることができる。

即ち、かかる一方の基板の電極上の被充塡而上の一点または複点に(等方性)液晶を適下、 散布またはコートし、他方の基板をこの上に配設する。 さらにこれらを真空引きをし、その前後において加熱し、その一対の基板を互いに加圧して、それぞれの基板の内側に設けられた被充して至いにFLC と密接せしめる。 さらにこの薄いFLC が充塡されラミネートされた基板の温度を降下させ、SmA を得、さらに双安ないの温度を降下させ、SmA を得、さらに双安ないの温度を降下させ、SmA を得、さらに双安ないの温度を降できる。するとらせん構造をとくことができる。この後、常温に保存した後、周辺部に対しシール用のプラスチック封止剤による封止を行う。

また本発明でも残された問題点の使用温度範囲は、現在複数の異なったFLC を組合わせて( ブレンドして) 0~50でにおいて使用が可能となっている。このため実用上はそれほど問題とならず、

周辺部の封止が劣化しやすい。またこの封止 材料が不純物として液晶内に混入しやすい。

- (4) 液晶の充壌に伴いセルギャップを決めている スペーサ (通称貝柱) が一方に偏りやすい。
- (5) 充垣の際有効に用いられない液晶材料が全体の90%近くになってしまい無駄が多い。

等の多くの欠点を有する。

本発明はかかる問題点を解くものである。 「問題を解決するための手段」

かかる問題を解決するため、本発明は、一対の 基仮に対し液晶を充塡する前に一対の基板の周辺 部をシールするのではなく、一方の基板上に液晶 を設けた後、この液晶上に他方の基板を密接せし め、さらに一対の基板を所定の相互位置に配設せ しめるものである。さらにこの工程の後工程とし て、周辺部に封止用シールを行わしめるいわゆる ラミネート(薄層にする、薄層にのばすの意)方 式を用いることを基本とする。

加えて本発明においては、液晶材料としてスメ クチック液晶、特に好ましくはスメクチックC相

(4)

また階調に関してはカラーも8色までとするならば階調が不要であり、マイクロコンピュータ等のディスプレイとしては十分実用が可能であることが判明した。

#### 「作用」

かくすることにより、

- (1) セルはスペーサを散布しその大きさにより最 小の間弦を決定するため、形成されるFLC の 間弦にばらつきがない。
- (2) 4 μ以下の間除(セル厚)の薄いセルであってかつ被充壌面が大面積(A4販相当)であっても短時間でラミネート作業を行うことができる。
- (3) 基板上に設けたPLC を100%有効利用すること ができる。
- (4) 粘度の高いFLC を用いても、そのラミネート および封止の作業に1時間以上を必要としない。
- (5) 一方の基板側にはアクティブ素子とそれに連結した電極を設けても、まったくアクティブ

(5)

素子を用いないハッシブ構造と同一工程でPLC のラミネートができる。

さらに、これらの特徴により本発明の液晶のラミネート(2つの基板の間隙を少しづつ狭くし、その間に液晶を薄層化して介在させることを示す)方法を用い、加えて非線型素子(NE)と強誘電性液晶(FLC)とを直列にして各画素を構成せしめる場合、A4版またはそれ以上の大面積のマトリックス化にそれぞれの画素間のクロストークを除去し駆動させることが初めて成就できた。

以下に実施例に従って本発明を説明する。 「実施例1」

第1図は本発明の液晶表示装置の作製工程を示す。

第1図(A) は2つの基板(I)、(1')を有する。この相対向する面(8)、(8')側にはそれぞれ電極を有している。またカラー表示をするには、その一方の側の電極と基板との間または電極と充塡される液晶との間にカラーフィルタが設けられている。さらにこの電極の上面には公知の非対称配向処理

(7)

返し得る。例えばここではSBとB7とのプレンドした液晶を用いた。

さらにこの一対の基板の一方の被充塡而上に液晶(2)を滴下させた。

かかる液晶が設けられた一対の基板を第1図(B) に示すごとき真空容器(100) に封入した。この真空容器(100) は第1の空間を有し、蓋倒(10') に第2の空間(5) を有する。第1の空間(4) 内にはヒータ(3) が設けられている。このヒータ(3) 上に一方の基板(1) を配設し、この基板を室温~150 で内の所定の温度、例えば液晶の粘度が十分低くなる70~150 で例えば120 でに加熱制御させた。

すると既に基板(1) 上の被充塡面に設けられた 被晶(3) が加熱される。この液晶を滴下して設け る前または後に所定の間隔をおいて基板上にスペーサを配設させた。このスペーサはまったく用い ない方式をとってもよい。

さらにこの上方に対向する他方の基板(l')を 1~10mm離間してまたはかるくお互いを部分的に接

がなされている。

これらの図面では、簡単にするため図示することを省略して単に基板として表記している。しかし一対の基板の相対向する側にこれらの電極、フィルタ、配向処理、ブラックマトリックス化するシェドウ処理(マスク)の形成、アクティブ素子の作製等を必要に応じて行うことは有効である。

また、基板は一般にはガラス基板例えばコーニング7059を使用する。しかし基板の一方または双方に可曲性の基板を用いることは有効である。そしてその可曲性基板として、化学強化がなされた0.3~0.6cm 厚のガラス基板、またはポリイミド。PAN、PET 等の透光性耐熱性有機樹脂基板を用いることは有効である。

この基板上の電極上には配向処理層(非対称配向処理層)が設けられ、その上面を被充電面とした。そしてこの面上にFLC 例えばSB(オクチル・オキシ・ベンジリデン・アミノ・メチル・ブチル・ベンゾエイト)を設けた。これ以外でもBOBAMBC、等のFLC または複数のブレンドを施したFLC を充

(8)

せしめて配置させた。

この後、この第2の空間(5)を有する蓋側容器(10)をつりングにより容器(10)側に合わせ込んだ。この第2の空間の下側には、第1の空間と第2の空間とがお互いに弾力性を有する層(以下簡単のためシリコンラバー(6)という)で遮蔽されている。そして第2の空間と第1の空間の圧力において、第1の空間の圧力が正圧の場合は下側を膨張し、逆の負圧の場合は上側に引っ張られるようになっている。このラバーは少なくとも150での温度に耐えることができる材料であれば、シリコンラバーにかぎらない。

これらを0リングにより互いに合わせ込み、(11)。(11') より同時に真空引きをした。即ち、この2つの出口は、パルブ(12)。(12')を経て真空ポンプ(14)に連結されている。そしてこのパルブ(12)。(12') をともに聞、パルブ(13)。(13')をともに聞として、第1および第2の空間(4)。(5) をともに真空空間とした。

さらに第1図(C) に示す如く、この上面に離間

している他方の基板を精密に配設した。

この後、他方の第2の空間(5) を真空状態より第1の空間(4) に比べて正圧となるように徐々にパルブ(13') より大気または窒素をリークし大気圧にさせた。

すると第1図(C) に示す如く、シリコンラバー (6) は下側に膨張し、対向する他方の基板(1')を一方の基板(1) の側に押しつける。そして大気圧においては $1 k g / c m^2$  の圧力を加えることができる。また窒素によりさらに加圧する場合は1気圧以上の $2 \sim 5 k g / c m^2$  の圧力とすることも可能である。

かくして一対の基板の全表面に均一な圧力を加えることができ、この圧力により液晶は一点また は複数点に点状に設けられていたが、横方向に基 板(1) の表面にそって広がり、ラミネートされる。

さらにその一対の基板の電極側の間酸は 4 μ以 下例えば 2 μの均一な厚さとすることができる。 そしてこの厚さはスペーサが 2 μの大きさのもの を予め配設しておくと 2 μとなり、1 μのスペー サを散布させておく時には 1 μとすることができ

(11)

り出し第1図(D) を作る。

かくして第1図(D) に示す如く、2つの対向する基板(1),(1')は液晶(3) を互いに実質的に重ね合わせた状態にする。

さらに第1図(E) に示すごとく、この基板を必要に応じて再加熱し、この周辺部に封止用シール剤(9)(一般にはプラスチック材料)を整布し、お互いの基板を固着させる。

かくして、本発明のスメクチック液晶の如く、 高い粘度を有する液晶、特にFLC の基板間での充 塩ラミネート方法を確立することができた。

かくすることにより、A4版(20cm ×30cmの面積) 1 校で使用する液晶は0.2cc で十分であり、3000 円/gと金より高価な液晶をきわめて有効に用いる ことができる。

1回の液晶の充壌作業を約1時間の短時間で行うことができる。

大面積になっても、作業時間は長くならないと いう特徴を有する。 δ.

もちろんスペーサをまったく用いず、この圧力 と加熱している温度とのみを特密に期間して所定 の壁さにラミネートさせることも可能である。

その結果、液晶の余分のものは周辺部に移動する。しかしこの外周辺をシリコンラバーが覆っているため、これが基板の一部の外側周辺より外側に液晶があふれることを実質的に防ぐことができる。またすべての外周辺より液晶があふれたり、また所望の領域全体を覆うことなく足りなくなったりすることは、初期の液晶の供給量を物密にすることにより防ぐことができる。

. 2つの基板のおたがいの X 方向 Y 方向の重ね合わせは密着させる基板 (1), (1') 及び液晶 (3) が加熱されている低粘度状態の時に移動させ再配設させることができる。

この後、第1図(C) でヒータを徐々に室温に降下した。さらに第1の空間(5) をも大気圧とし真空容器(100) の薫(10') を取り外した。一対の基板間に液晶をラミネートさせたセルを容器より取

(12)

即ち、従来より公知のTN液晶の充壌作業においては、この液晶に応力が加わらないようにすることが主である。そのため、周辺部のシール剤はおたがいの基板に外部より加わり得る圧力が液晶それ自体に加わらないよう互いの力を支えている。

しかしスメクチック液晶では、この力が液晶それ自体に加わってもその粘度が大きく、差し支えないことを本発明人は見出した。そしてこの特性を利用することにより従来とはまったく異なる本発明の如き作闘方法を可能にすることができた。

以上の本発明の液晶の充壌方法において、被充 域面を構成する配向処理層を非対称配向処理とし、 一方をラピング処理をし、他方を非ラピング処理 とする。この時、本発明の如くラミネイトした後、 この悲板をラピングを施した面にそって高温状態 等で微動(1μ以上の1~10・μの)させ、ストレ スを液晶に加え配向せしめることは有効である。

以上に述べた本発明の液晶表示装置において、 この基板の一方または双方の基板の外側に偏光板 を設け、反射型とする場合は、その入射光側の電

(13)

極を透光性とし、他方を反射型電極とする。そしてFLC のチルト角を約45度とすることにより、 L 枚のフィルタを入射光側の基板上に配設して実施 することができる。

他方、2枚のフィルタを用いて透過型または反射型とする場合は、2枚の偏光板をそれぞれの基板の外側に配向させ、FLC のチルト角を約22.5度とすることにより成就させ得る。透光型においてはパックライトをLL(エレクトロ・ルミネッセンス) 蛍光灯または自然光により照射し、透光する光の量を制御することによりディスプレイとすることができる。

カラー化する場合は他方の対向基板側(人間の目で見える側)の電極の上側または下側にカラーフィルタを設ければよい。

さらに本発明においては、基板上に非線型素子を配設し、その上方に電極を設けたものを基板として取扱い、アクティブ素子型とすることができる。かかる場合、この非線型素子としてNIN型等の複合ダイオード構造を有するSCLAD(空間電荷網

限電流型アモルファス半導体装置)、絶縁ゲイト 型電界効果半導体装置を用いることが可能である。

本発明の液晶表示装置において、ライトベンを 用いたフォトセンサをドット状に作ることにより 表示とその読み取りとを行うことができる。

本発明の第1図の作製工程は100 ×100(カラー においては100 ×300)のマトリックス構成とした。

しかしこのドット数は640 ×400(カラーの場合は1920×400),720×400 その他の構成をも有し得る。

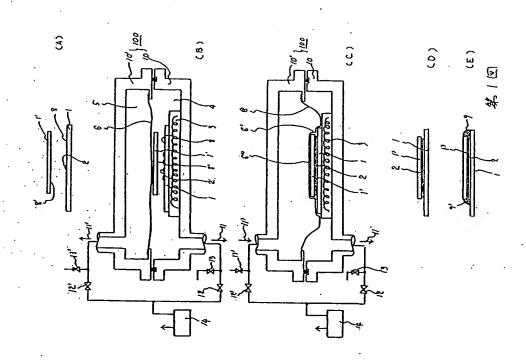
### 5.図面の簡単な説明

第1図は本発明の液晶表示装置の作製方法を示す。

特許出願人 株式会社半導体エネルギー研究所 代製者 山 崎 舜 平 (全点)

(15)

(16)



第1]	頁の紅	売き						
<b>@</b> %	明	者	小	柳	かお	る	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体ェ
@発	明	者	<b>今</b>	任	慎	=	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
@発	明	者	ኪ	П	利	治	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ
0発	明	者	坂	間.	光	範		株式会社半導体ェ
@発	明	者	犬	島		喬	東京都世田谷区北烏山7丁目21番21号 ネルギー研究所内	株式会社半導体エ